### 

UDC 621.791.36:669.225:546.284'171

# 銀ロウを用いた窒化ケイ素の接合

Bonding of Silicon Nitride Using Siliver Filler

王 建 義\* • 市野瀬 英 喜\* • 田 中 俊一郎\* • 石 田 洋 一\* Jian-Yih WANG, Hideki ICHINOSE, Shyunichiro TANAKA and Yoichi ISHIDA

1.はじめに

窒化ケイ素は構造用セラミックスとして現在最も期待 されている。一方、銀ロウ(Ag-Cu合金)は接合時に液 相となって良好な接合を生ずる金属として最も一般的で ある。接合界面を活性化させるため、このAg-Cu共晶合 金(Ag-28%Cu)に数%のTiを固溶させ、窒化ケイ素と の濡れ性を向上させ、窒化ケイ素と接合した<sup>1)</sup>、接合界面 にどのような相が生成して、強固な接合を生じているか を各種の電子顕微鏡を用い観察した。本研究は接合メカ ニズムを解明し、良好な接合体の設計指針を得ることを 目的とする。

### 2.実験方法

実験に用いられたセラミックスは㈱東芝製の常圧焼結 の $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>であり、焼結助剤としてY<sub>2</sub>O<sub>3</sub>やAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>等を含 むものである。接合に用いたロウ材はTi濃度2.2~4.9% を含む厚さ50~100 $\mu$ mのクラッド状ないしは合金状の Ag-Cu-Ti合金である。AgとCu組成比は共晶組成のそれ に合わせてある。接合条件は10<sup>-5</sup>Torrの真空中で880° C×7minを基本とした。接合試料は、はじめに10×5× 0.3mmの板状に切り出し、これをダイヤモンド研磨によ り100 $\mu$ m位まで薄くし、超音波カッターで直径3mmの 試料に打ち抜き、さらに、ディンプラを用い、試料の中 心部を20 $\mu$ mまで削った。それを5KeVのAr<sup>+</sup>中でイオン 研磨して電子顕微鏡で観察した。使用した電顕は JEM1250超高圧電顕、JEM200CX(改)高分解能電顕お よびJEM2000FX分析電顕である。

# 3.実験結果

写真1はSi<sub>a</sub>N<sub>4</sub>/Ag-Cu-Ti/Si<sub>a</sub>N<sub>4</sub>接合体界面の低倍率 電顕組織である。イオン研磨に対する接合体界面層の抵 抗が窒化ケイ素や銀ロウのそれよりずっと強いために、 幅約3 $\mu$ mのイオンミリングされにくい層が橋桁状につ

\*東京大学生産技術研究所 第4部

きだしてつながっている。中央部分は銀ロウに相当し, 両側の研磨されてなくなっているところが窒化ケイ素で ある。ロウ材部分の組織は写真2に示されるように,転 位を多量に含むマトリックスのAgと,塊状を呈するCu



写真1 接合体断面の低倍率透過電顕像



写真2 ロウ材部分の微細組織

霍 報 谏

の共晶組織で、粗大な柱状晶の組織も含んでいる。写真 3は銀ロウとこの界面層の微細組織である。銀ロウが凝 固する際,窒化ケイ素に対してエピタキシーを保って生 長する傾向を持つために,共晶がラメラー状になる。冷 却の際に熱膨張率の差によって生じたと思われる多数の 転位がこの銀ロウのところに見えている。柱状晶の組成 分析 (EDX) を行った. その結果, 図1に示されるよう に、この柱状晶はTiを多く含むTi-Si-N化合物であるこ とがわかった.

一方,界面層は写真1に示されるように直径3µm位 の粗結晶と、とくに外側、窒化ケイ素側に直径50nm位の 微結晶から構成されている。回折パターンによれば、こ の粗結晶は母材の窒化ケイ素と同様の構造を持つ、窒化 ケイ素に重なっている微粒子は、高分解能観察(写真4) によると,窒化ケイ素にエピ関係を持って析出している ことがみられ、その組成はEDXにより、TiNおよびチタ ンのシリサイドと思われた。いずれにしても、この界面 の組成分析の結果は、図2に示しているように元素の分 布が複雑になっており、特にチタンがこの界面に多量に 集中していることを示している.本来チタンは銀ロウの



写真3 ロウ材と生成物界面層の組織



写真 4 

中に均一に固溶していたものであり、これが接合の際に 強く界面に集まってくるという現象は、チタンが窒化ケ イ素を分解して、その生成物であるTiNあるいはチタン シリサイドを形成する自由エネルギーが、AgまたはCu のチタン化合物のそれよりずっと低いためと解釈される.

### 4 考 寏

この接合体では、イオン研磨の際に界面層と窒化ケイ 素との間で亀裂が生じやすい、このことは、界面層と銀 ロウとの界面では,銀ロウ側に転位が高密度に存在し, この界面上の歪みを緩和してしまっているからと思われ る. 窒化ケイ素と界面層の間は微粒子があるから歪みを 分散させやすいにもかかわらず,割れているのは,両者 が金属でないためで熱歪みが緩和せず亀裂面となるもの と考えられる.とはいえ、この接合は強度的には一応十 分であるが、Tiを減らし界面層をなくすることにより、 強度がさらに上がると期待されている.



The Distance from the Silicon Nitride Side  $(\mu m)$ 

図2 界面層の組成分析結果 窒化ケイ素表面層の微細粒子の高分解能像

n

380 40巻8号(1988.8)

### 

5.まとめ

銀ロウを用いた窒化ケイ素の接合界面組織を高分解能 電子顕微鏡および分析電顕により,生成物および異相界 面の微細構造を明らかにした。主な結果は次のとおりで ある。

(1)本接合系における生成物は、ロウ材金属の場合には、 CuおよびAgからなる共晶組織のほかに、Ti-Si-Nの柱 状粗結晶であり、橋桁状な中間層の場合には、窒化ケイ 素と同じ構造を持つ大きさ2µm位な粗結晶と、TiNま たはチタンシリサイトと思われる微結晶である。

(2)チタンは界面に多量に集中している。これは、チタンのNitrideあるいはSilicideの形成自由エネルギーが、

AgまたはCuのチタン化合物のそれより低いためである. (3)本接合系の接合強度は一応十分である(200~300 MPa)が、チタンを減らし界面層の厚さを減らすことに より、さらに強度が上がると期待されている.

## 辞

謝

本実験の遂行に当たって、日本電子㈱の柴富室長に分 析電顕を実施して頂いた。ここに深く感謝の意を表する。 (1988年5月13日受理)

### 参考文献

 石田洋一 市野瀬英喜 田中俊一郎:日本金属学会秋 大会一般講演概要, 1987, 10, 421

